

16 марта, среда – 3 стендовая сессия

**МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУР**

- Ср 1 А.Н. Анисимов, Р.А. Бабунц, Д.О. Толмачев, Е.Н. Мохов, В.А. Солтамов, П.Г. Баранов, Г.В. Астахов, В.В. Дьяконов
Антипересечение уровней энергии кремниего-углеродного вакансионного центра, находящегося в политипах 4H, 6H, 15R карбида кремния
- Ср 2 Н.А. Бекин, А.В. Антонов, Р.Х. Жукавин, Д.В. Юрасов, Д.В. Козлов, В.Н. Шастин
Влияние проводимости по примесной зоне на эффект Холла в гетероструктурах p-Ge/GeSi с легированными квантовыми ямами
- Ср 3 Н.В. Востоков, В.И. Шашкин
СВЧ-диагностика низкобарьерных структур металл-полупроводник
- Ср 4 В.А. Голяшов, К.А. Кох, О.Е. Терещенко
Транспортные свойства топологических изоляторов Bi₂Te₃ и Bi_xSb_{2-x}Te₃ с p-n переходом
- Ср 5 Д.А. Грачев, А.В. Белолипецкий, А.С. Гарахин, А.В. Нежданов, И.А. Карабанова, О.М. Сресели, А.В. Ершов
Влияние температурного воздействия на формирование нанокристаллов Ge в пленках GeO_x
- Ср 6 Д.А. Грачев, А.В. Ершов, А.В. Нежданов, А.Н. Яблонский, Б.А. Андреев
Фазовые модификации диэлектрических композитов с массивами нанокристаллов германия
- Ср 7 Ю. Греченков
Моделирование кристаллической фазы нитевидных нанокристаллов из элементов III и V групп таблицы Менделеева
- Ср 8 С. В. Гудина, Ю.Г. Арапов, А.П. Савельев, В.Н. Неверов, Н.Г. Шелушинина, М.В. Якунин, И.С. Васильевский, А.Н. Виниченко
Квантовый эффект Холла и прыжковая проводимость в наногетероструктурах n- InGaAs/InAlAs
- Ср 9 В.М. Данильцев, Е.В. Демидов, М.Н. Дроздов, Ю.Н. Дроздов, Е. А. Сузовегина, В.И. Шашкин, П.А. Юнин
Сильнолегированные слои GaAs:Te, полученные в процессе МОГФЭ с использованием диизопропилтеллурида в качестве источника
- Ср 10 Е.С. Демидов, А.С. Абросимов, В.В. Карзанов, Н.Е. Демидова
Люминесцентные, парамагнитные и электротранспортные свойства пористого кремния в зависимости от частоты и характера изменения плотности тока при его анодном формировании
- Ср 11 А.П. Деточенко, С.А. Денисов, М.Н. Дроздов, А.И. Машин, В.А. Гавва, А.Д. Буланов, А.В. Нежданов, А.А. Ежевский, М.В. Степихова, В.Ю. Чалков, В.Н. Трушин, Д.В. Шенгуров, В.Г. Шенгуров, N.V. Abrosimov, H. Riemann
Эпитаксиальные моноизотопные слои Si, Ge и Si_{1-x}Ge_x